Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0210U007856

Державний реєстраційний номер: 0109U005913

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 24-12-2010

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: 91Халькогенідні та оксидні матеріали для ІЧ-техніки, оптоелектроніки, дозиметрії, сонячної енергетики, сенсорики, спінтроніки та фотоніки.

Початок етапу: 07.2009

Закінчення етапу: 12.2010

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 52-61-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201060

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 2

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Халькогенідні та оксидні матеріали для ІЧ-техніки, оптоелектроніки, дозиметрії, сонячної енергетики, сенсорики, спінтроніки та фотоніки.

Назва роботи англійською:

Chalcogenide and oxide materials for IR-technique, optoelectronics, dosimetry, solar power engineering, sensorics, spintronics and photonics

Реферат українською:

Створено на основі досліджуваних матеріалів лабораторні зразки фоточутливих та світловипромінюючих структур, детекторів іонізуючого випромінювання, перетворювачів сонячної енергії, газових сенсорів; встановлені за допомогою Х-променевих, електрофізичних, оптичних, магнітних, люмінесцентних, фотоелектричних та імпедансних методів основні закономірності протікання електронних процесів у створених на основі досліджуваних матеріалів пристроях у залежності від технологічних умов отримання матеріалу та виготовлення структур. Розроблено науково-обгрунтовані фізичні моделі відгуку оксидних і халькогенідних матеріалів і створених на їх основі структур на дію зовнішніх факторів; розроблено рекомендації щодо можливостей використання досліджуваних матеріалів у якості робочих елементів нових або з покращеними експлуатаційними характеристиками конкурентноспроможних мікроелектронних приладів спеціального та побутового призначення, зокрема, високоефективних фотоприймачів, світловипромінюючих структур, перетворювачів сонячної енергії, газових сенсорів тощо.

Реферат англійською:

Laboratory samples of photosensitive and light-emitting structures, detectors of ionizing radiation, solar energy converters, gas sensors have been created on the basis of materials under study; X-ray, electrophysical, optical, magnetic, luminescent, photoelectric and impedance methods have been used to establish the basic regularities of electronic processes taking place in devices created on the basis of materials being investigated depending on the technological conditions of material preparation and structures manufacture. Science-based physical models of the response of oxide and chalcogenide materials and structures on their basis to the external actions have been elaborated; recommendations have been given as to the possibilities of using materials under investigation as the operating elements of new or enhanced-performance competitive microelectronic devices of special and domestic application, in particular, high-performance photodetectors, light-emitting structures, solar energy converters, gas sensors, etc.

Індекс УДК: 537.311.322, 621.315.592,537.228,537.312.5

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мар"янчук Павло Дмитрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1.D.M.Zayachuk, V.I.Mikityuk, V.M.Frasunyak, V.V.Shlemkevych. High temperature transformation in the defects and impurities system of PbTe:Eu crystals // Journal of Crystal Growth. 311 (2009). - PP.4670-4674. 2.В.В. Брус, З.Д. Ковалюк, П.Д. Марьянчук, И.Г. Орлецкий, Э. В. Майструк Свойства металлических контактов на пленках TiO2, изготовленных методом реактивного магнетронного распыления // Технология и конструирование в электронной апаратуре. - 2010. № , С.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Ушенко Олександр Григорович
д. ф.-м. н., 01.04.05

Перелік осіб-виконавців

Ілащук Марія Іванівна

Андрущак Галина Олегівна

Брус Віктор Васильович

Білічук Сергій Васильович

Грушка Олена Григорівна

Димко Лариса Миколаївна

Катеринчук Валерій Миколайович

Ковалюк Захар Дмитрович

Козярський Іван Петрович

Козярський Дмитро Петрович

Мар"янчук Павло Дмитрович

Микитюк Василь Іванович

Нетяга Вівкот Васильович

Орлецький Іван Григорович

Парфенюк Орест Архипович

Сльотов Олексій Михайлович

Ульяницький Костянтин Сергійович

Фрасуняк Василь Михайлович

Хомяк Володимир Васильович

Шлемкевич Володимир Васильович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

